

製品概要

NIS6150: +5 ボルト電子 eFuse

技術情報は、データシートをご参照ください。

NIS6150 は、費用効率が高くリセット可能なヒューズで、壊滅的障害とシャットダウン障害のいずれに対しても、USB アプリケーションの信頼性を大幅に強化します。センシティブな回路を損傷する入力過電圧から負荷デバイスをバッファ化し、入力側の回路を逆電流から保護するよう設計されています。内蔵の過電圧クランプ回路は、過渡時の出力電圧を制限しますが、ユニットのシャットダウンはしないため、負荷デバイスの動作は継続できます。

特長

- 200 mΩ Max RDS(on)
 - Integrated Reverse Current Protection
 - Adjustable Output Current Limit Protection with Thermal Shutdown
 - IEC61000-4-2 Level 4 ESD Protection for Vbus up to ±8 kV
 - Fast Response Overvoltage Clamp Circuit with Selectable Level
 - Digital Enable with Separate FLAG pins
 - Integrated Current Monitoring
 - Both Latching and Auto-Retry Options Available
 - NIV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC-Q100 Qualified and PPAP Capable
 - These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant
- For more features, see the data sheet

利点

- Increased Efficiency
- Automotive Short-to-Battery Protection
- Accurate Over-current Protection for Sensitive Loads
- Robust System Level ESD Protection
- Accommodating for different VBUS drive levels
- Load Diagnostics and fault identification
- Load Diagnostics
- Fail-Open Options
- Automotive Qualified

アプリケーション

- USB 2.0/3.0/3.1 VBUS
- USB Type-C PD Charging
- Solid State Drives
- Mother Boards

最終製品

- Solid State Drives
- Automotive Infotainment

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Type	V _I Max (V)	r _{DS(on)} Max (mΩ)	T _{SD} Typ (°C)	T _{hyst} Typ (°C)	Package Type
NIS6150MT1TXG	0.3851	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	Latch	10	200	175	45	WDFNW-10
NIS6150MT2TXG	0.3851	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	Auto-Retry	10	200	175	45	WDFNW-10
NIV6150MT1TXG	0.4547	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	Latch	10	200	175	45	WDFNW-10
NIV6150MT2TXG	0.4547	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	Auto-Retry	10	200	175	45	WDFNW-10

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

